

©1993

ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС ФТОРА В ЧАСТИЧНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МУЛЬТИХРОМНЫХ СТЕКЛАХ

*В. Васицкий, В. М. Микушев, Н. В. Никоноров, З. Пайонк,
Е. И. Панышева, И. В. Туниманова, Е. В. Чарная*

Методом ЯМР ^{19}F исследован процесс формирования микрокристаллической фазы NaF в мультихромных стеклах. Определены общий объем микрокристаллической фазы, размеры микрокристаллов и др. Продемонстрирована информативность метода ЯМР для изучения частично-кристаллических стекол.

Мультихромные стекла представляют собой частично-кристаллическую гетерогенную структуру, состоящую из стеклянной матрицы на алюмосиликатной основе с микрокристаллами галоидов натрия, выделившимися внутри матрицы в результате ионно-диффузионных процессов. Как показано в [1], мультихромные стекла являются перспективными материалами для создания элементов оптической памяти и записи голограмм. Схема процесса формирования микрокристаллической фазы детально описана в [2,3]. Согласно [2,4], состав, форма, концентрация и размер микрокристаллов, а также связанные с этими факторами цвет и интенсивность окрашивания стекла существенно зависят от режимов облучения и термообработки исходного материала.

В частности, если исходные стекла выдерживать без предварительного облучения при температуре, близкой к температуре стеклования, то в нем образуются микрокристаллы NaF, величина которых определяется длительностью термообработки. Рост микрокристаллов NaF непосредственно проявляется в изменении коэффициента пропускания видимого света и может быть проконтролирован с помощью оптических методов, а также рентгеноструктурного анализа [3].

Однако к настоящему времени не существует надежных данных относительно размеров микрокристаллов и концентрации микрокристаллической фазы, поскольку методы малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, успешно применяемые для определения размеров микрокристаллов в фотохромных стеклах и т.п. в случае мультихромных стекол являются малоэффективными из-за близости электронной плотности NaF и стеклянной матрицы. Нами с целью получения информации о формировании микрокристаллической фазы в мультихромных стеклах использовался метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

1. Образцы и экспериментальная методика

Исследуемые мультихромные стекла имели следующий состав (в вес. %): $\text{SiO}_2 = 70.7$, $\text{Na}_2\text{O} = 15.7$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 3.1$, $\text{ZnO} = 6.2$, $\text{F}^- = 2.4$, $\text{Br}^- = 1.8$, $\text{Sb}_2\text{O}_3 = 0.1$, $\text{CeO}_2 = 0.02$ и $\text{Ag}^+ = 0.02$. Кристаллы NaF образовывались в матрице при температуре 500°C [3] в течение времени t , равном 2, 8 и 20 ч (образцы 1, 2 и 3, соответственно). После термообработки образец 1 сохранял свою первоначальную оптическую прозрачность, тогда как для образцов 2 и 3 оптическая плотность значительно увеличивалась. Рост кристаллов контролировался методом рентгеноструктурного анализа и по изменению оптической плотности на длине волны 600 нм.

Время спин-решеточной релаксации T_1 ядер ^{19}F измерялось на импульсном спектрометре ЯМР на частоте около 60 МГц в диапазоне температур 95–290 К по восстановлению сигнала ядерной намагниченности после импульсного насыщения. Точность термостабилизации составляла не менее 1 К. Дополнительно измерялась форма линии ЯМР на стационарном спектрометре широких линий при частоте 28 МГц.

2. Экспериментальные результаты и обсуждение

Полученные данные относительно скорости спин-решеточной релаксации свидетельствуют о существенном изменении T_1 в процессе формирования микрокристаллической фазы. Во всем исследованном температурном диапазоне релаксация в образце 1 имеет экспоненциальный характер, тогда как в образцах 2 и 3 можно выделить два различных экспоненциальных вклада, соответствующих двум временам спин-решеточной релаксации. На рис. 1 в качестве примера представлены зависимости ядерной намагниченности от времени t восстановления сигнала ЯМР после насыщения во всех трех образцах при температуре 120 К.

Температурные зависимости времени T_1 в образце 1 и длины составляющей релаксации в образцах 2 и 3 представлены на рис. 2. Из рис. 2 видно, что время релаксации во всех трех образцах несколько увеличивается с уменьшением температуры, а затем осциллирует около некоторого температуронезависимого значения.



Рис. 1. Временная зависимость восстановления сигнала ядерной намагниченности M после импульсного насыщения в образцах 1 (а), 2 (б) и 3 (в).

Для образца 3 отдельно показан вклад короткой составляющей. M_0 — равновесная намагниченность.

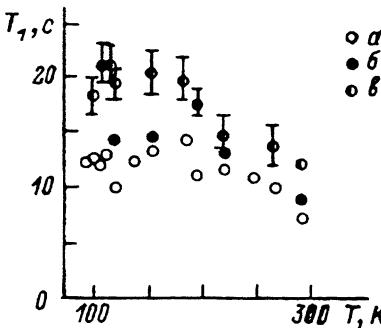


Рис. 2. Температурная зависимость времени релаксации фтора в образцах 1 (а), 2 (б) и 3 (в).

Для образцов 2 и 3 показаны только вклады длинной составляющей. Погрешность указана только в тех случаях, когда она превышает размер экспериментальных точек.

Доля короткой составляющей в образце 3 составляет приблизительно 35%, в образце 2 — около 15%. Величину короткой составляющей времени спин-решеточной релаксации с достаточной степенью точности можно было оценить только для образца 3 и для температур ниже 200 К, где она четче выделяется на фоне увеличивающегося времени длинной составляющей. Для этих температур время короткой составляющей практически оставалось постоянным и равным приблизительно 3 с.

Как хорошо известно, спин-решеточная релаксация ядер ^{19}F , обладающих спином $I = 1/2$, в твердых диамагнетиках осуществляется за счет взаимодействия с парамагнитными центрами, всегда присутствующими в реальных средах [5]. При этом процесс релаксации может осуществляться с участием или без участия спиновой диффузии в зависимости от концентрации парамагнитных центров, расстояния между резонирующими ядрами и степени неоднородного уширения линии ЯМР. В мультихромных стеклах парамагнитными центрами служат ядра церия, концентрация которых более чем на порядок выше концентрации неконтролируемых парамагнитных примесей, содержащихся в стекле. Принимая во внимание концентрации ионов фтора и церия, задаваемые составом исходного стекла, а также измеренную ширину линии ЯМР фтора, равную 1.9 ± 0.4 Гц, можно заключить, что спин-решеточная релаксация в образце 1, в котором, согласно [3], доля микрокристаллической фазы пренебрежимо мала и процесс релаксации совпадает с релаксацией в матричном стекле, реализуется с участием спиновой диффузии. В таком случае время релаксации фтора в образце 1 дается выражением [5]

$$\left(T_1^{(1)} \right)^{-1} = 4\pi \cdot 0.7 N_{\text{Ce}} C^{1/4} D_1^{3/4}, \quad (1)$$

где C — эффективный параметр электрон-ядерного взаимодействия для ионов церия, D_1 — коэффициент спиновой диффузии, N_{Ce} — число ионов церия в единице объема (в (1) использовано приближение малого диффузионного барьера).

В образце 3, согласно [3], достигается максимально возможный объем микрокристаллической фазы. При этом часть фтора входит в состав микрокристаллов, а часть остается растворенной в матрице стекла, причем количество остающегося в матрице фтора неизвестно. Не имеется также данных относительно размеров микрокристаллов. Поскольку для образца 3 наблюдались методом ЯМР две группы ядер фтора с различными временами спин-решеточной релаксации, то можно предположить,

что одно из этих времен соответствует фтору в стекле, а другое — фтору в микрокристаллах NaF.

Для количественного анализа рассмотрим модель образца 3, состоящего из микрокристаллов NaF объемом $V_0^{(3)}$ и равномерно распределенного в стеклянной матрице фтора. Время спин-решеточной релаксации фтора, растворенного в стекле, $(T_1^{(3)})_{\text{gl}}$ дается выражением (1), в котором число ионов церия и параметр C остаются неизменными, а коэффициент спиновой диффузии изменяется из-за увеличения расстояния между ионами фтора. В таком случае из (1) можно получить соотношение между $T_1^{(1)}$ и $(T_1^{(3)})_{\text{gl}}$

$$T_1^{(1)} / (T_1^{(3)})_{\text{gl}} = \left(D_3^{\text{gl}} / D_1 \right)^{3/4}, \quad (2)$$

где D_3^{gl} — коэффициент спиновой диффузии в стеклянной фазе образца 3. Поскольку, как показали измерения ширины линии ЯМР фтора, она остается одинаковой для всех исследуемых образцов, то [5]

$$D_1 / D_3^{\text{gl}} = \left(r_F^{(3)} / r_F^{(1)} \right)^4, \quad (3)$$

где r_F — расстояние между ядрами фтора в стекле для образцов 1 и 3. Тогда с помощью (3) из (2) можно получить

$$\frac{T_1^{(1)}}{(T_1^{(3)})_{\text{gl}}} = \left(\frac{r_F^{(1)}}{r_F^{(3)}} \right)^3 = \frac{N_F^{(3)}}{N_F^{(1)}}, \quad (4)$$

где $N_F^{(1)}$ — число ионов фтора в стекле для образца 1 и $N_F^{(3)}$ — число ионов фтора в стекле для образца 3.

Поскольку в процессе выделения микрокристаллической фазы расстояние между ионами фтора в стекле увеличивается, то следует предположить, что фтору в стекле соответствует длинная компонента релаксации в образце 3. Подставляя в (4) экспериментальные значения времен спин-решеточной релаксации, получаем $N_F^{(3)} = 0.63 N_F^{(1)}$, что хорошо согласуется с долей длинно релаксирующих ядер фтора, оцененной по виду кривой восстановления намагниченности.

В таком случае быструю компоненту времени релаксации можно приписать ядрам фтора, находящимся в микрокристаллах. При росте микрокристаллов NaF происходит вытеснение ионов другого сорта из объема кристаллов, вследствие чего расстояния между ядрами фтора и парамагнитными ионами церия будут определяться размерами микрокристалла. Тогда время релаксации фтора в кристаллах NaF будет даваться формулой (1), в которой роль N_{Ce} играет $1/V_0^{(3)}$. Между временами $T_1^{(1)}$ и временем короткой составляющей в образце 3 $(T_1^{(3)})_{\text{cr}}$, соответствующей фтору в микрокристаллах, должно выполняться соотношение

$$\frac{(T_1^{(3)})_{\text{cr}}}{T_1^{(1)}} = N_{\text{Ce}} V_0^{(3)} \left(\frac{D_1}{D_3^{\text{cr}}} \right)^{3/4} = N_{\text{Ce}} V_0^{(3)} \frac{N_F^{(1)}}{N_F^{\text{cr}}}, \quad (5)$$

где N_F^{cr} — число ядер фтора в единице объема кристалла NaF.

Зная состав стеклянной матрицы, ее плотность ($\rho = 2.5 \text{ г/см}^3$), а также параметры кристалла NaF, нетрудно получить оценки: $N_{Ce} = 1.7 \cdot 10^{18}$, $N_F^{(1)} = 1.9 \cdot 10^{21}$, $N_F^{cr} = 2.0 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$. Подставляя для $(T_1^{(3)})_{cr}$ и $T_1^{(1)}$ их значения при низких температурах: $(T_1^{(3)})_{cr} \approx 3 \text{ с}$, $(T_1^{(1)}) \approx 12 \text{ с}$, можно оценить средний объем микрокристаллов в образце 3 $V_0^{(3)} \approx 1.5 \cdot 10^3 \text{ нм}^3$ и их поперечный размер $d_0^{(3)} \approx 11 \text{ нм}$. Используя полученные выше результаты, можно также оценить общий относительный объем микрокристаллической фазы $\delta V_3 = (N_F^{(1)} - N_F^{(3)}) / N_F^{cr} \approx 0.035$ и число микрокристаллов в единице объема $n_3 = \delta V_3 / V_0^{(3)} \approx 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$.

Аналогичные оценки для образца 2 приводят к следующим величинам для количества ионов фтора в стеклянной фазе $N_F^{(2)}$ и относительному объему микрокристаллической фазы δV_2 : $N_F^{(2)} = N_F^{(1)} \left(T_1^{(1)} / (T_1^{(2)})_{gl} \right) \approx \approx 0.83 N_F^{(1)}$ и $\delta V_2 = (N_F^{(1)} - N_F^{(2)}) / N_F^{cr} \approx 0.015$. Оценка $N_F^{(2)}$ хорошо согласуется с долей быстро релаксирующих ионов, определенной по временной зависимости восстановления намагниченности.

Таким образом, в настоящей работе методом ЯМР для мультихромных стекол определены общее количество ионов фтора, вошедшее в микрокристаллы, общий объем микрокристаллической фазы и размеры отдельных микрокристаллов NaF. Для образца, полученного выдержкой исходной матрицы при температуре 500° С в течение 20 ч, найденный общий объем микрокристаллов NaF составляет 0.035 от общего объема образца, средний объем одного микрокристалла равен $\sim 1.5 \cdot 10^3 \text{ нм}^3$, число микрокристаллов в единице объема равно $2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ и относительное количество ионов фтора, вошедших в микрокристаллы, составляет 0.35 от общего количества ионов фтора, присутствовавших в исходной матрице. Для образца, полученного выдержкой исходной матрицы при температуре 500° С в течение 8 ч, относительное количество ионов фтора, вошедших в микрокристаллы, составляет 0.15 от количества ионов фтора в исходной матрице. А общий объем микрокристаллов NaF составляет 0.015 от общего объема образца.

На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что ЯМР является резульвативным методом изучения процесса формирования микрокристаллической фазы в матрице стекла.

Список литературы

- [1] Глебов Л.В., Никоноров Н.В., Панышева Е.И., Петровский Г.Т. Саввин В.В., Туниманова И.В., Цехомский В.А. // ДАН СССР. 1990. Т. 314. № 4. С. 849–853.
- [2] Stookey S.D., Beall G.H., Pierson J.S. // J. Appl. Phys. 1978. V. 49. N 10. P. 5114–5122.
- [3] Астахова В.В., Никоноров Н.В., Панышева Е.И., Саввин В.В., Туниманова И.В., Цехомский В.А. // Физика и химия стекла. 1992. Т. 18. № 2. С. 248–252.
- [4] Панышева Е.И., Туниманова И.В., Цехомский В.А. // Физика и химия стекла. 1990. Т. 16. № 2. С. 239–244.
- [5] Абрагам А. Ядерный магнетизм. М.: ИЛ, 1963.